









	<h2 style="color: #E67E22;">SI8851EDB-T2-E1</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI8851EDB-T2-E1
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 7.7A MICRO FOOT
	Datenblätter:  SI8851EDB-T2-E1.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI8851EDB-T2-E1
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 7.7A MICRO FOOT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	Power Micro Foot®
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 7A, 4.5V
Verlustleistung (max)	660mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	30-XFBGA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6900pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	180nC @ 8V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.7A (Ta)

SI8851EDB-T2-E1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8851EDB-T2-E1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8851EDB-T2-E1 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI8851EDB-T2-E1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI88620EC-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 20SOIC</p>	 <p>SI88620BD-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 20SOIC</p>	 <p>SI88444EC-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 20SOIC</p>	 <p>SI88444EC-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 20SOIC</p>
 <p>SI88620BC-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 20SOIC</p>	 <p>SI8851EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 7.7A MICRO FOOT</p>	 <p>SI88620BC-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 20SOIC</p>	 <p>SI88443EC-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 20SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI8851EDB-T2-E1 Vishay / Siliconix	SI8851EDB-T2-E1 Datenblatt	SI8851EDB-T2-E1-Datenblätter	SI8851EDB-T2-E1 PDF	Vishay / Siliconix SI8851EDB-T2-E1
SI8851EDB-T2-E1 Electronic	SI8851EDB-T2-E1-Komponenten	SI8851EDB-T2-E1-Verteiler	SI8851EDB-T2-E1-Bild	SI8851EDB-T2-E1-Teil
SI8851EDB-T2-E1 Preis	SI8851EDB-T2-E1 Hersteller	SI8851EDB-T2-E1 Bild	SI8851EDB-T2-E1 Aktie	SI8851EDB-T2-E1 Inventar
SI8851EDB-T2-E1 Neu	SI8851EDB-T2-E1 Original	SI8851EDB-T2-E1 garantiert	SI8851EDB-T2-E1 RFQ	SI8851EDB-T2-E1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited